

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6326833号
(P6326833)

(45) 発行日 平成30年5月23日(2018.5.23)

(24) 登録日 平成30年4月27日(2018.4.27)

(51) Int.Cl. F I
A 6 1 B 8/14 (2006.01) A 6 1 B 8/14
H 0 4 R 17/00 (2006.01) H 0 4 R 17/00 3 3 0 J
 H 0 4 R 17/00 3 3 2

請求項の数 19 (全 18 頁)

<p>(21) 出願番号 特願2014-16639 (P2014-16639) (22) 出願日 平成26年1月31日 (2014.1.31) (65) 公開番号 特開2015-142629 (P2015-142629A) (43) 公開日 平成27年8月6日 (2015.8.6) 審査請求日 平成29年1月13日 (2017.1.13)</p>	<p>(73) 特許権者 000002369 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 (74) 代理人 100116665 弁理士 渡辺 和昭 (74) 代理人 100164633 弁理士 西田 圭介 (74) 代理人 100179475 弁理士 仲井 智至 (72) 発明者 清瀬 摂内 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 審査官 永田 浩司</p>
--	--

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 超音波デバイス、超音波デバイスの製造方法、プローブ、電子機器、超音波画像装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

アレイ状に配置された複数の薄膜型超音波トランスデューサー素子を含む素子アレイを有する基板と、

前記素子アレイを覆う音響整合層と、

前記音響整合層の上に配置された音響レンズと、

前記音響レンズおよび前記基板の間に配置されて、前記音響整合層の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有する保護膜と、

を備え、

前記保護膜は、前記音響レンズの母線に平行である前記音響整合層の側面にそれぞれ接触する2つの側面で前記音響整合層を挟むことを特徴とする超音波デバイス。

10

【請求項 2】

請求項1に記載の超音波デバイスにおいて、前記保護膜は、前記音響レンズの母線に交差する前記音響整合層の側面にそれぞれ接触する2つの側面で前記音響整合層を挟むことを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 3】

請求項2に記載の超音波デバイスにおいて、前記保護膜は前記基板の表面に沿って前記音響整合層を囲むことを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 4】

請求項1～3のいずれか1項に記載の超音波デバイスにおいて、前記音響レンズは、前

20

記基板に向き合う面から前記基板に向かって突き出る柱状部を有し、前記音響整合層は、前記柱状部に接触する内側面を有することを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の超音波デバイスにおいて、前記基板の厚み方向の平面視で前記音響整合層の輪郭の外側で前記基板に結合されるフレキシブルプリント配線板をさらに備え、前記保護膜は前記音響整合層と前記フレキシブルプリント配線板との間で前記基板上の導電体に被さることを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 6】

請求項 5 に記載の超音波デバイスにおいて、前記保護膜は前記フレキシブルプリント配線板上に配置されていることを特徴とする超音波デバイス。

10

【請求項 7】

請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の超音波デバイスと、前記超音波デバイスを支持する筐体とを備えることを特徴とするプローブ。

【請求項 8】

請求項 7 に記載のプローブにおいて、前記保護膜は前記筐体に固定されることを特徴とするプローブ。

【請求項 9】

請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の超音波デバイスと、前記超音波デバイスに接続されて、前記超音波デバイスの出力を処理する処理部とを備えることを特徴とする電子機器。

20

【請求項 10】

請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の超音波デバイスと、前記超音波デバイスに接続されて、前記超音波デバイスの出力を処理し、画像を生成する処理部と、前記画像を表示する表示装置とを備えることを特徴とする超音波画像装置。

【請求項 11】

アレイ状に配置された複数の薄膜型超音波トランスデューサー素子を含む素子アレイを有する基板と、

前記素子アレイを覆って、第 1 圧縮強さを有する音響整合層と、

前記音響整合層の上に配置されて、第 1 圧縮強さよりも小さい第 2 圧縮強さを有する音響レンズと、

30

を備えることを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 12】

請求項 11 に記載の超音波デバイスにおいて、前記音響整合層は単一層であることを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 13】

請求項 12 に記載の超音波デバイスにおいて、前記音響整合層の音響インピーダンスは 2 MRays 以下であることを特徴とする超音波デバイス。

【請求項 14】

請求項 13 に記載の超音波デバイスにおいて、前記音響整合層の膜厚は $100 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする超音波デバイス。

40

【請求項 15】

アレイ状に配置された複数の薄膜型超音波トランスデューサー素子を含む素子アレイを有する基板に、前記基板の厚み方向の平面視で前記素子アレイが配置される領域の両側にマスキング材を配置する工程と、

前記マスキング材の間で前記素子アレイ上に音響整合層および音響レンズを配置し、前記音響レンズおよび前記基板の間に前記マスキング材を挟む工程と、

前記マスキング材を外して、前記音響レンズおよび前記基板の間に配置されて、前記音響整合層の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有する保護膜を形成する工程と、

を備えることを特徴とする超音波デバイスの製造方法。

【請求項 16】

50

請求項 15 に記載の超音波デバイスの製造方法において、
前記マスキング材を外した後に、前記領域の両側で前記領域と前記基板の縁との間にフレキシブルプリント配線板を結合する工程と、
前記音響整合層および前記フレキシブルプリント配線板の間に流動性を有する樹脂材を流し込み、当該樹脂材を硬化させて前記保護膜を形成する工程と、
を備えることを特徴とする超音波デバイスの製造方法。

【請求項 17】

請求項 15 または 16 に記載の超音波デバイスの製造方法において、
前記音響レンズの配置にあたって前記マスキング材は両側から前記音響レンズを位置決めすることを特徴とする超音波デバイスの製造方法。

10

【請求項 18】

請求項 17 に記載の超音波デバイスの製造方法において、
前記マスキング材は開口を有し、前記マスキング材は開口内の前記音響レンズに対して四方から位置決めを実施することを特徴とする超音波デバイスの製造方法。

【請求項 19】

請求項 18 に記載の超音波デバイスの製造方法において、前記音響整合層の配置にあたって前記開口には流動性を有する樹脂材が流し込まれ、前記樹脂材の厚みは前記マスキング材の厚みで制御されることを特徴とする超音波デバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

20

【0001】

本発明は、超音波デバイス、並びに、それを利用したプローブ、電子機器および超音波画像装置等に関する。

【背景技術】

【0002】

特許文献 1 に開示されるように、超音波診断装置といった超音波画像装置は一般に知られる。超音波画像装置はアレイ状に配置された複数の超音波トランスデューサー素子を備える。超音波トランスデューサー素子はいわゆる c M U T (静電容量型) 振動子で形成される。超音波トランスデューサー素子のアレイには音響レンズが被さる。音響レンズは接着剤で超音波トランスデューサー素子のアレイに接着される。音響レンズはシリコンゴムから形成される。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2008 - 193357 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

生体とのマッチングにあたって音響レンズは生体に近い音響インピーダンスを有する。したがって、音響レンズは生体と同程度の柔らかさを有する。音響レンズが生体に押し当てられると、音響レンズには超音波トランスデューサー素子のアレイに向かって押し付け力が作用する。音響レンズは圧縮される。こうして音響レンズが歪むと、音響レンズの焦点位置にずれが生じる。鮮明な超音波画像が得られない。

40

【0005】

そして、生体に押し付けられる際に音響レンズの歪みを抑制することができる超音波デバイスが望まれていた。

【課題を解決するための手段】

【0006】

(1) 本発明の一態様は、アレイ状に配置された複数の薄膜型超音波トランスデューサー素子を含む素子アレイを有する基板と、前記素子アレイを覆う音響整合層と、前記音響

50

整合層の上に配置された音響レンズと、前記音響レンズおよび前記基板の間に配置されて、前記音響整合層の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有する構造体とを備える超音波デバイスに関する。

【0007】

音響レンズが生体に押し当てられると、音響レンズには基板に向かって押し付け力が作用する。このとき、構造体は音響整合層の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有することから、押し付け力の方向に音響レンズは構造体で受け止められる。こうして音響レンズに押し付け力が加わっても、音響レンズの歪みは防止される。超音波デバイスでは押し付け力に対して十分に音響レンズの歪みは抑制される。

【0008】

(2) 前記構造体は、前記音響レンズの母線に平行である前記音響整合層の側面にそれぞれ接触する2つの側面で前記音響整合層を挟むことができる。音響レンズには1中心線に平行な母線で形成される部分円筒面が規定される。部分円筒面は超音波の収束に用いられる。部分円筒面で超音波の焦点位置が決定される。構造体の側面は母線に交差する方向に音響整合層を挟むことから、音響レンズの母線に平行な輪郭に沿って音響レンズは構造体で支持される。一般に、音響レンズは母線に交差する方向に比べて母線に平行な方向に長い。したがって、音響整合層を挟む構造体同士の間隔は狭まる。こうして音響レンズの歪みは効果的に抑制される。

【0009】

(3) 前記構造体は、前記音響レンズの母線に交差する前記音響整合層の側面にそれぞれ接触する2つの側面で前記音響整合層を挟むことができる。ここでは、構造体の側面は音響レンズの母線に沿った方向に音響整合層を挟むことから、音響レンズの母線に交差する方向の輪郭に沿って音響レンズは構造体で支持される。こうして音響レンズの歪みはさらに効果的に抑制される。

【0010】

(4) 前記構造体は前記基板の表面に沿って前記音響整合層を囲んでもよい。音響整合層に押し付け力が作用しても、音響整合層の潰れは構造体で防止される。音響整合層の変形は防止される。音響レンズは構造体および音響整合層で効果的に支持される。音響レンズの歪みは抑制される。

【0011】

(5) 前記音響レンズは、前記基板に向き合う面から前記基板に向かって突き出る柱状部を有することができ、前記音響整合層は、前記柱状部に接触する内側面を有してもよい。こうした構造によれば、音響レンズおよび音響整合層の界面に沿って剪断方向に音響レンズおよび音響整合層のずれは防止される。音響レンズおよび音響整合層は強固に重なり合って積層体を構成する。こうした積層体は音響レンズの歪みの抑制をさらに強化する。

【0012】

(6) 超音波デバイスは、前記基板の厚み方向の平面視で前記音響整合層の輪郭の外側で前記基板に結合されるフレキシブルプリント配線板をさらに備えてもよい。このとき、前記構造体は前記音響整合層と前記フレキシブルプリント配線板との間で前記基板上の導電体上に配置されればよい。素子アレイとフレキシブルプリント配線板とは基板上の導電体で相互に電氣的に接続される。導電体は音響整合層とフレキシブルプリント配線板との間で構造体で覆われることから、導電体の露出は回避される。こうして基板上の導電体は保護される。

【0013】

(7) 前記構造体は前記フレキシブルプリント配線板上に配置されることができる。構造体はフレキシブルプリント配線板の固定強度を補強することができる。

【0014】

(8) 超音波デバイスはプローブに組み込まれて利用されることができる。このとき、プローブは、超音波デバイスと、前記超音波デバイスを支持する筐体とを備えればよい。

【0015】

10

20

30

40

50

(9) プローブでは、前記構造体は前記筐体に固定されてもよい。プローブの製造にあたって超音波デバイスは筐体に收容される。筐体内で構造体は超音波デバイスの移動を防止する。音響レンズは確実に筐体に固定される。

【0016】

(10) 超音波デバイスは電子機器に組み込まれて利用されることができる。このとき、電子機器は、超音波デバイスと、前記超音波デバイスに接続されて、前記超音波デバイスの出力を処理する処理部とを備えることができる。

【0017】

(11) 超音波デバイスは超音波画像装置に組み込まれて利用されることができる。このとき、超音波画像装置は、超音波デバイスと、前記超音波デバイスに接続されて、前記超音波デバイスの出力を処理し、画像を生成する処理部と、前記画像を表示する表示装置とを備えることができる。

10

【0018】

(12) 本発明の他の態様は、アレイ状に配置された複数の薄膜型超音波トランスデューサー素子を含む素子アレイを有する基板と、前記素子アレイを覆って、第1圧縮強さを有する音響整合層と、前記音響整合層の上に配置されて、第1圧縮強さよりも小さい第2圧縮強さを有する音響レンズとを備える超音波デバイスに関する。

【0019】

音響レンズが生体に押し当てられると、音響レンズには基板に向かって押し付け力が作用する。このとき、押し付け力の方向に音響レンズは音響整合層で受け止められる。音響整合層が音響レンズと同等な圧縮強さを有する場合に比べて、音響整合層の潰れは防止される。こうして音響レンズに押し付け力が加わっても、音響レンズの歪みは防止されることができる。超音波デバイスでは押し付け力に対して十分に音響レンズの歪みは抑制されることができる。

20

【0020】

(13) 前記音響整合層は単一層であることができる。その結果、音響整合層が複数層で形成される場合に比べて、音響整合層の形成工程は簡素化されることができる。しかも、音響整合層の膜厚は高い精度で制御されることができる。

【0021】

(14) 前記音響整合層の音響インピーダンスは 2 MRayls 以下であることができる。音響レンズと薄膜型トランスデューサー素子との間で音響インピーダンスの整合は確立されることができる。例えばバルク型トランスデューサー素子に比べて音響整合層は薄膜化される。

30

【0022】

(15) 前記音響整合層の膜厚は $100 \mu\text{m}$ 以下であることができる。薄膜化に応じて音響整合層の変形は抑制される。しかも、超音波デバイスは小型化される。

【0023】

(16) 本発明の他の態様は、アレイ状に配置された複数の薄膜型超音波トランスデューサー素子を含む素子アレイを有する基板に、前記基板の厚み方向の平面視で前記素子アレイが配置される領域の両側にマスキング材を配置する工程と、前記マスキング材の間で前記素子アレイ上に音響整合層および音響レンズを配置し、前記音響レンズおよび前記基板の間に前記マスキング材を挟む工程と、前記マスキング材を外して、前記音響レンズおよび前記基板の間に配置されて、前記音響整合層の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有する構造体を形成する工程とを備える超音波デバイスの製造方法に関する。こうして前述の超音波デバイスを製造することができる。

40

【0024】

(17) 超音波デバイスの製造方法は、前記マスキング材を外した後に、前記領域の両側で前記領域と前記基板の縁との間にフレキシブルプリント配線板を結合する工程と、前記音響整合層および前記フレキシブルプリント配線板の間に流動性を有する樹脂材を流し込み、当該樹脂材を硬化させて前記構造体を形成する工程とを備えてもよい。

50

【 0 0 2 5 】

素子アレイとフレキシブルプリント配線板とは基板上の導電体で相互に電氣的に接続される。導電体は音響整合層とフレキシブルプリント配線板との間で構造体で覆われることから、導電体の露出は回避される。構造体の形成にあたって音響整合層およびフレキシブルプリント配線板の間の空間には樹脂材が流し込まれる。樹脂材は確実に導電体に被さることができる。その一方で、例えば滴下された樹脂材が他の部材で押し広げられて空間に樹脂材が充填される場合には、空間の隅に樹脂材が十分に行き渡ることができない。

【 0 0 2 6 】

(1 8) 超音波デバイスの製造方法では、前記音響レンズの配置にあたって前記マスキング材は両側から前記音響レンズを位置決めしてもよい。マスキング材の働きで音響レンズを高い精度で素子アレイに対して位置決めすることができる。

10

【 0 0 2 7 】

(1 9) 前記マスキング材は開口を有することができ、前記マスキング材は開口内の前記音響レンズに対して四方から位置決めを実施してもよい。マスキング材の働きで高い精度で素子アレイに対して音響レンズを位置決めすることができる。

【 0 0 2 8 】

(2 0) 前記音響整合層の配置にあたって前記開口には流動性を有する樹脂材が流し込まれ、前記樹脂材の厚みは前記マスキング材の厚みで制御されてもよい。開口は基板上に素子アレイを囲む枠体を区画する。枠体には音響整合層の樹脂材が流し込まれる。樹脂材の流れは堰き止められる。こうして音響整合層の形状は整えられる。こうして音響整合層の厚みを決定することができる。

20

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 9 】

【 図 1 】 一実施形態に係る電子機器の一具体例すなわち超音波診断装置を概略的に示す外觀図である。

【 図 2 】 超音波プローブの拡大正面図である。

【 図 3 】 第 1 実施形態に係る超音波デバイスの拡大平面図である。

【 図 4 】 図 3 の A - A 線に沿った断面図である。

【 図 5 】 超音波デバイスの斜視図である。

【 図 6 】 図 5 の B - B 線に沿った断面図である。

30

【 図 7 】 超音波デバイスの製造方法を示す図であって、基板上に形成されたマスキング材を概略的に示す部分拡大断面図である。

【 図 8 】 超音波デバイスの製造方法を示す図であって、素子アレイ上に流し込まれた樹脂材を概略的に示す部分拡大断面図である。

【 図 9 】 超音波デバイスの製造方法を示す図であって、マスキング材の開口に設置された音響レンズを概略的に示す部分拡大断面図である。

【 図 1 0 】 超音波デバイスの製造方法を示す図であって、マスキング材が外された後に基板に結合された第 1 配線板および第 2 配線板を概略的に示す部分拡大断面図である。

【 図 1 1 】 超音波デバイスの製造方法を示す図であって、基板上に形成された保護膜を概略的に示す部分拡大断面図である。

40

【 図 1 2 】 第 1 変形例に係る超音波デバイスを概略的に示す垂直断面図である。

【 図 1 3 】 図 4 に対応し、第 2 変形例に係る超音波デバイスを概略的に示す断面図である。

【 図 1 4 】 図 4 に対応し、第 3 変形例に係る超音波デバイスを概略的に示す断面図である。

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 3 0 】

以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。

50

【 0 0 3 1 】

(1) 超音波診断装置の全体構成

図 1 は本発明の一実施形態に係る電子機器の一具体例すなわち超音波診断装置（超音波画像装置）11の構成を概略的に示す。超音波診断装置11は装置端末（処理部）12と超音波プローブ（プローブ）13とを備える。装置端末12と超音波プローブ13とはケーブル14で相互に接続される。装置端末12と超音波プローブ13とはケーブル14を通じて電気信号をやりとりする。装置端末12にはディスプレイパネル（表示装置）15が組み込まれる。ディスプレイパネル15の画面は装置端末12の表面で露出する。装置端末12では、超音波プローブ13で検出された超音波に基づき画像が生成される。画像化された検出結果がディスプレイパネル15の画面に表示される。

10

【 0 0 3 2 】

図 2 に示されるように、超音波プローブ13は筐体16を有する。筐体16内には超音波デバイス17が収容される。超音波デバイス17の表面は筐体16の表面で露出することができる。超音波デバイス17は表面から超音波を出力するとともに超音波の反射波を受信する。その他、超音波プローブ13は、プローブ本体13aに着脱自在に連結されるプローブヘッド13bを備えることができる。このとき、超音波デバイス17はプローブヘッド13bの筐体16内に組み込まれることができる。

【 0 0 3 3 】

図 3 は超音波デバイス17の平面図を概略的に示す。超音波デバイス17は基体（基材）21を備える。基体21には素子アレイ22が形成される。素子アレイ22はアレイ状に配置された超音波トランスデューサー素子（以下「素子」という）23の配列で構成される。配列は複数行複数列のマトリクスで形成される。その他、配列では千鳥配置が確立されてもよい。千鳥配置では偶数列の素子23群は奇数列の素子23群に対して行ピッチの2分の1でずらされればよい。奇数列および偶数列の一方の素子数は他方の素子数に比べて1つ少なくてもよい。

20

【 0 0 3 4 】

個々の素子23は振動膜24を備える。図 3 では振動膜24の膜面に直交する方向の平面視（基板の厚み方向からの平面視）で振動膜24の輪郭が点線で描かれる。振動膜24上には圧電素子25が形成される。圧電素子25は上電極26、下電極27および圧電体膜28で構成される。個々の素子23ごとに上電極26および下電極27の間に圧電体膜28が挟まれる。これらは下電極27、圧電体膜28および上電極26の順番で重ねられる。超音波デバイス17は1枚の超音波トランスデューサー素子チップ（基板）として構成される。

30

【 0 0 3 5 】

基体21の表面には複数本の第1導電体29が形成される。第1導電体29は配列の行方向に相互に平行に延びる。1行の素子23ごとに1本の第1導電体29が割り当てられる。1本の第1導電体29は配列の行方向に並ぶ素子23の圧電体膜28に共通に接続される。第1導電体29は個々の素子23ごとに上電極26を形成する。第1導電体29の両端は1対の引き出し配線31にそれぞれ接続される。引き出し配線31は配列の列方向に相互に平行に延びる。したがって、全ての第1導電体29は同一長さを有する。こうしてマトリクス全体の素子23に共通に上電極26は接続される。第1導電体29は例えばイリジウム（Ir）で形成されることができる。ただし、第1導電体29にはその他の導電材が利用されてもよい。第1導電体29および引き出し配線31は積層された導電層をパターンングすることで形成された配線部に相当する。

40

【 0 0 3 6 】

基体21の表面には複数本の第2導電体32が形成される。第2導電体32は配列の列方向に相互に平行に延びる。1列の素子23ごとに1本の第2導電体32が割り当てられる。1本の第2導電体32は配列の列方向に並ぶ素子23の圧電体膜28に共通に配置される。第2導電体32は個々の素子23ごとに下電極27を形成する。第2導電体32には例えばチタン（Ti）、イリジウム（Ir）、白金（Pt）およびチタン（Ti）の積

50

層膜が用いられることができる。ただし、第2導電体32にはその他の導電材が利用されてもよい。第2導電体32は積層された導電層をパターニングすることで形成された配線部に相当する。

【0037】

列ごとに素子23の通電は切り替えられる。こうした通電の切り替えに応じてリニアスキャンやセクタースキャンは実現される。1列の素子23は同時に超音波を出力することから、1列の個数すなわち配列の行数は超音波の出力レベルに応じて決定されることができる。行数は例えば10～15行程度に設定されればよい。図中では省略されて5行が描かれる。配列の列数はスキャンの範囲の広がりに応じて決定されることができる。列数は例えば128列や256列に設定されればよい。図中では省略されて8列が描かれる。上電極26および下電極27の役割は入れ替えられてもよい。すなわち、マトリクス全体の素子23に共通に下電極が接続される一方で、配列の列ごとに共通に素子23に上電極が接続されてもよい。

10

【0038】

基体21の輪郭は、相互に平行な1対の直線で仕切られて対向する第1辺21aおよび第2辺21bを有する。第1辺21aと素子アレイ22の輪郭との間に1ラインの第1端子アレイ33aが配置される。第2辺21bと素子アレイ22の輪郭との間に1ラインの第2端子アレイ33bが配置される。第1端子アレイ33aは第1辺21aに平行に1ラインを形成することができる。第2端子アレイ33bは第2辺21bに平行に1ラインを形成することができる。第1端子アレイ33aは1対の上電極端子34および複数の下電極端子35で構成される。同様に、第2端子アレイ33bは1対の上電極端子36および複数の下電極端子37で構成される。1本の引き出し配線31の両端にそれぞれ上電極端子34、36は接続される。引き出し配線31および上電極端子34、36は素子アレイ22を二等分する垂直面で対称に形成されればよい。1本の第2導電体32の両端にそれぞれ下電極端子35、37は接続される。第2導電体32および下電極端子35、37は素子アレイ22を二等分する垂直面で対称に形成されればよい。ここでは、基体21の輪郭は矩形に形成される。基体21の輪郭は正方形であってもよく台形であってもよい。

20

【0039】

基体21には第1フレキシブルプリント配線板(以下「第1配線板」という)38が連結される。第1配線板38は第1端子アレイ33aに覆い被さる。第1配線板38の一端には上電極端子34および下電極端子35に個別に対応して導電線すなわち第1信号線39が形成される。第1信号線39は上電極端子34および下電極端子35に個別に向き合わせられ個別に接合される。同様に、基体21には第2フレキシブルプリント配線板(以下「第2配線板」という)41が覆い被さる。第2配線板41は第2端子アレイ33bに覆い被さる。第2配線板41の一端には上電極端子36および下電極端子37に個別に対応して導電線すなわち第2信号線42が形成される。第2信号線42は上電極端子36および下電極端子37に個別に向き合わせられ個別に接合される。

30

【0040】

図4に示されるように、基体21は基板44および被覆膜45を備える。基板44の表面に被覆膜45が一面に形成される。基板44には個々の素子23ごとに開口46が形成される。開口46は基板44に対してアレイ状に配置される。開口46が配置される領域の輪郭は素子アレイ22の輪郭に相当する。隣接する2つの開口46の間には仕切り壁47が区画される。隣接する開口46は仕切り壁47で仕切られる。仕切り壁47の壁厚みは開口46の間隔に相当する。仕切り壁47は相互に平行に広がる平面内に2つの壁面を規定する。壁厚みは2つの壁面の距離に相当する。すなわち、壁厚みは壁面に直交して壁面の間に挟まれる垂線の長さで規定されることができる。基板44は例えばシリコン基板で形成されればよい。

40

【0041】

被覆膜45は、基板44の表面に積層される酸化シリコン(SiO_2)層48と、酸化

50

シリコン層 48 の表面に積層される酸化ジルコニウム (ZrO_2) 層 49 とで構成される。被覆膜 45 は開口 46 に接する。こうして開口 46 の輪郭に対応して被覆膜 45 の一部が振動膜 24 を形成する。振動膜 24 は、被覆膜 45 のうち、開口 46 に臨むことから基板 44 の厚み方向に膜振動することができる部分である。酸化シリコン層 48 の膜厚は共振周波数に基づき決定されることができる。

【0042】

振動膜 24 の表面に下電極 27、圧電体膜 28 および上電極 26 が順番に積層される。圧電体膜 28 は例えばジルコン酸チタン酸鉛 (PZT) で形成されることができる。圧電体膜 28 にはその他の圧電材料が用いられてもよい。ここでは、第 1 導電体 29 の下で圧電体膜 28 は完全に第 2 導電体 32 を覆う。圧電体膜 28 の働きで第 1 導電体 29 と第 2 導電体 32 との間で短絡は回避されることができる。

10

【0043】

基体 21 の表面には音響整合層 51 が積層される。音響整合層 51 は素子アレイ 22 を覆う。音響整合層 51 の膜厚は振動膜 24 の共振周波数に応じて決定される。音響整合層 51 には例えばシリコーン樹脂膜が用いられることができる。音響整合層 51 は第 1 端子アレイ 33a および第 2 端子アレイ 33b の間の空間に収まる。音響整合層 51 の縁は基体 21 の第 1 辺 21a および第 2 辺 21b から離れる。音響整合層 51 は基体 21 の輪郭よりも小さい輪郭を有する。

【0044】

音響整合層 51 上には音響レンズ 52 が配置される。音響レンズ 52 の輪郭は音響整合層 51 の輪郭よりも外側に描かれる。したがって、音響整合層 51 の輪郭の周囲では音響レンズ 52 と基体 21 の表面との間に空間が形成される。音響レンズ 52 の縁は基体 21 の第 1 辺 21a および第 2 辺 21b から離れる。音響レンズ 52 は音響整合層 51 の表面に密着する。音響レンズ 52 は音響整合層 51 の働きで基体 21 に接着される。音響レンズ 52 の外表面は部分円筒面で形成される。部分円筒面は第 1 導電体 29 に平行な母線を有する。部分円筒面の曲率は、1 筋の第 2 導電体 33 に接続される 1 列の素子 23 から発信される超音波の焦点位置に応じて決定される。音響レンズ 52 は例えばシリコーン樹脂から形成される。音響レンズ 52 は生体の音響インピーダンスに近い音響インピーダンスを有する。

20

【0045】

基体 21 には保護膜 (構造体) 53 が固定される。保護膜 53 は例えばエポキシ樹脂といった遮水性を有する素材から形成される。ただし、保護膜 53 はその他の樹脂材から形成されてもよい。少なくとも基体 21 の表面に直交する方向に保護膜 53 は音響整合層 51 の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有する。保護膜 53 は音響整合層 51 の周囲で音響レンズ 52 および基体 21 の間に挟まれる。一般に、シリコーン樹脂の圧縮強さは概ね 58.8 [MPa] 以上 98.06 [MPa] 未満であって、エポキシ樹脂の圧縮強さは概ね 98.06 [MPa] 以上 196.12 [MPa] 以下であることから、エポキシ樹脂の保護膜 53 はシリコーン樹脂の音響整合層 51 よりも大きい圧縮強さを有する。圧縮強さは日本工業規格 (JIS) K7181 に則って計測されたものである。

30

【0046】

ここでは、保護膜 53 は音響レンズ 52 および音響整合層 51 の側面 52a、51a に固着される。側面 52a、51a は基体 21 の表面に垂直に広がる。図 4 では、保護膜 53 は、音響レンズ 52 の母線に平行に広がり基体 21 に直角に交差する 2 つの仮想平面 54a、54b にそれぞれ沿った接触面 53a、53b で音響整合層 51 および音響レンズ 52 をそれぞれ挟む。保護膜 53 は、音響整合層 51 と第 1 および第 2 配線板 38、41 との間で基体 21 表面の第 2 導電体 32 や引き出し配線 31 に被さる。同様に、保護膜 53 は、基体 21 上で第 1 配線板 38 および第 2 配線板 41 の端部に被さる。

40

【0047】

基体 21 の裏面にはバッキング材 56 が固定される。バッキング材 56 の表面に基体 21 の裏面が重ねられる。バッキング材 56 は超音波デバイス 17 の裏面で開口 46 を閉じ

50

る。バックング材 5 6 はリジッドな基材を備えることができる。ここでは、仕切り壁 4 7 はバックング材 5 6 に結合される。バックング材 5 6 は個々の仕切り壁 4 7 に少なくとも 1 カ所の接合域で接合される。接合にあたって接着剤は用いられることができる。

【 0 0 4 8 】

図 5 に示されるように、保護膜 5 3 は平面視で音響レンズ 5 2 の輪郭に沿って音響レンズ 5 2 を囲む。保護膜 5 3 は音響レンズ 5 2 の輪郭と基体 2 1 の周縁との間で枠形状に広がる。図 6 に示されるように、枠形状の形成にあたって保護膜 5 3 は音響レンズ 5 2 および音響整合層 5 1 の側面 5 2 b、5 1 b に固着される。側面 5 2 b、5 1 b は基体 2 1 の表面に垂直に基体 2 1 の表面から立ち上がり側面 5 2 b、5 1 b に垂直に接続される。保護膜 5 3 は、音響レンズ 5 2 の母線に直角に交差しつつ基体 2 1 に直角に交差する 2 つの仮想平面 5 7 a、5 7 b にそれぞれ沿った接触面 5 3 c、5 3 d で音響整合層 5 1 および音響レンズ 5 2 をそれぞれ挟む。

10

【 0 0 4 9 】

(2) 超音波診断装置の動作

次に超音波診断装置 1 1 の動作を簡単に説明する。超音波の送信にあたって圧電素子 2 5 にはパルス信号が供給される。パルス信号は下電極端子 3 5、3 7 および上電極端子 3 4、3 6 を通じて列ごとに素子 2 3 に供給される。個々の素子 2 3 では下電極 2 7 および上電極 2 6 の間で圧電体膜 2 8 に電界が作用する。圧電体膜 2 8 は超音波の周波数で振動する。圧電体膜 2 8 の振動は振動膜 2 4 に伝わる。こうして振動膜 2 4 は超音波振動する。その結果、対象物（例えば人体の内部）に向けて所望の超音波ビームは発せられる。

20

【 0 0 5 0 】

超音波の反射波は振動膜 2 4 を振動させる。振動膜 2 4 の超音波振動は所望の周波数で圧電体膜 2 8 を超音波振動させる。圧電素子 2 5 の圧電効果に応じて圧電素子 2 5 から電圧が出力される。個々の素子 2 3 では上電極 2 6 と下電極 2 7 との間で電位が生成される。電位は下電極端子 3 5、3 7 および上電極端子 3 4、3 6 から電気信号として出力される。こうして超音波は検出される。

【 0 0 5 1 】

超音波の送信および受信は繰り返される。その結果、リニアスキャンやセクタスキャンは実現される。スキャンが完了すると、出力信号のデジタル信号に基づき画像が形成される。形成された画像はディスプレイパネル 1 5 の画面に表示される。

30

【 0 0 5 2 】

超音波画像の形成にあたって音響レンズ 5 2 は生体に押し当てられる。音響レンズ 5 2 が生体に押し当てられると、音響レンズ 5 2 には基体 2 1 に向かって押し付け力が作用する。このとき、保護膜 5 3 は音響整合層 5 1 の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有することから、押し付け力の方向に音響レンズ 5 2 は保護膜 5 3 で受け止められる。こうして音響レンズ 5 2 に押し付け力が加わっても、音響レンズ 5 2 の歪みは防止されることができる。超音波デバイス 1 7 では押し付け力に対して十分に音響レンズ 5 2 の歪みは抑制されることができる。

【 0 0 5 3 】

前述のように、音響レンズ 5 2 には 1 中心線に平行な母線で形成される部分円筒面が規定される。部分円筒面は超音波の収束に用いられる。部分円筒面で超音波の焦点位置が決定される。保護膜 5 3 の接触面 5 3 a は母線に直角に交差する方向に音響整合層 5 1 を挟むことから、音響レンズ 5 2 の母線に平行な輪郭に沿って音響レンズ 5 2 は保護膜 5 3 で支持される。音響レンズ 5 2 は母線に交差する方向に比べて母線に平行な方向に長い。したがって、母線に直角に交差する方向に保護膜 5 3 同士の間隔は狭まる。こうして音響レンズ 5 2 の歪みは効果的に抑制される。音響レンズ 5 2 の焦点位置は決められた位置に維持されることができる。音響レンズ 5 2 に歪みが生じてしまうと、音響レンズ 5 2 の焦点位置にずれが生じることが懸念される。焦点位置がずれてしまうと、精密な超音波画像は描き出されることができない。しかも、本実施形態では、保護膜 5 3 は音響レンズ 5 2 の母線に沿った方向に接触面 5 3 c で音響整合層 5 1 を挟む。音響レンズ 5 2 の母線に交差

40

50

する方向の輪郭に沿って音響レンズ52は保護膜53で支持される。こうして音響レンズ52の歪みはさらに効果的に抑制される。特に、保護膜53は基体21の表面に沿って音響整合層51を囲む。したがって、音響整合層51は基体21の表面、音響レンズ52および保護膜53で封入される。封入された空間では音響整合層51の移動は防止されることから、音響整合層51に押し付け力が作用しても音響整合層51の潰れは防止される。音響整合層51の変形は防止される。音響レンズ52は保護膜53および音響整合層51で効果的に支持される。音響レンズ52の歪みは抑制される。

【0054】

超音波デバイス17では素子アレイ22と第1および第2配線板38、41とは基体21上の第2導電体33や引き出し配線31で相互に電氣的に接続される。保護膜53は音響整合層51と第1および第2配線板38、41との間で基体21上の第2導電体32や引き出し配線31に被さる。こうして第2導電体33や引き出し配線31は音響整合層51と第1および第2配線板38、41との間で保護膜53で覆われることから、第2導電体33や引き出し配線31の露出は回避される。こうして基体21上の導電体は保護される。特に、保護膜53に遮水性が付与されると、第2導電体33や引き出し配線31は水分や湿気から保護され、第2導電体33や引き出し配線31といった導電材同士の短絡は防止されることができ。前述のように、保護膜53が第1および第2配線板38、41の端部に被さると、保護膜53は第1および第2配線板38、41の固定強度を補強することができる。

【0055】

(3) 超音波デバイスの製造方法

次に超音波デバイス17の製造方法を説明する。図7に示されるように、基板61が用意される。基板61は、基材62上にアレイ状に配置された複数の素子23を含む素子アレイ22を有する。基材62は前述の基体21に相当する。基材62上にマスキング材63が積層される。マスキング材63は平面視で素子アレイ22の輪郭と基材62の周縁との間に囲い形状に形成される。マスキング材63は素子アレイ22上に開口64を形成する。開口64は基材62上に素子アレイ22を囲む枠体を区画する。したがって、マスキング材63は平面視で第2導電体33の延伸方向に素子アレイ22の輪郭の両側に配置されると同時に第1導電体29の延伸方向に素子アレイ22の輪郭の両側に配置される。ここでは、マスキング材63は2層の積層構造に形成される。下層63aの厚みは音響整合層51の膜厚に一致する。下層63aで形成される枠体は下側開口64aを区画する。上層63bは、平面視で下側開口64aの輪郭よりも外側に広がる上側開口64bを区画する。したがって、下側開口64aと上側開口64bとの間には段差が形成される。マスキング材63には例えばフォトレジストが用いられることができる。

【0056】

続いて、マスキング材63の開口64内で素子アレイ22上に音響整合層51および音響レンズ52は配置される。これらの配置にあたって、図8に示されるように、マスキング材63の開口64に音響整合層51の樹脂材66は流し込まれる。樹脂材66は流動性を有する。樹脂材66は下層63aの下側開口64aを満たす。樹脂材66の流れはマスキング材63の下層63aで堰き止められる。こうして音響整合層51の形状は整えられる。樹脂材66は下層63aの下側開口64a内で満遍なく広がる。ここでは、下層63aの厚みに基づき樹脂材66の容量は調整される。下層63aの厚みの働きで樹脂材66の厚みは高い精度で制御されることができ。

【0057】

図9に示されるように、マスキング材63の開口64内で樹脂材66上に音響レンズ52が重ねられる。音響レンズ52と基材62との間にマスキング材63の下層63aは挟まれる。音響レンズ52は予め決められた形状に加工されていればよい。マスキング材63の上層63bは、平面視で第2導電体33の延伸方向に両側から音響レンズ52を位置決めし、同時に、第1導電体29の延伸方向に両側から音響レンズ52を位置決めする。したがって、マスキング材63の上層63bは上側開口64b内の音響レンズ52に対し

て四方から位置決めを実施する。マスキング材 6 3 の上層 6 3 b の働きで音響レンズ 5 2 は高い精度で素子アレイ 2 2 に対して位置決めされることができる。ここでは、音響レンズ 5 2 の縁は上層 6 3 b の壁面に面接触する。樹脂材 6 6 は熱や紫外線の照射に応じて硬化する。樹脂材 6 6 は硬化して音響整合層 5 1 を形成する。こうして音響レンズ 5 2 は素子アレイ 2 2 に接着される。

【 0 0 5 8 】

図 1 0 に示されるように、音響整合層 5 1 が硬化すると、マスキング材 6 3 は外される。マスキング材 6 3 は例えばエッチング処理その他で除去されればよい。下層 6 3 a の段差の働きで音響レンズ 5 2 と基材 6 2 との間には空間が区画される。

【 0 0 5 9 】

マスキング材 6 3 が外されると、基材 6 2 の表面で素子アレイ 2 2 の輪郭と基材 6 2 の周縁との間で第 1 端子アレイ 3 3 a および第 2 端子アレイ 3 3 b は露出する。マスキング材 6 3 が外された後に、素子アレイ 2 2 の輪郭と基材 6 2 の周縁との間に第 1 配線板 3 8 および第 2 配線板 4 1 がそれぞれ結合される。第 1 配線板 3 8 は第 1 端子アレイ 3 3 a に被さる。第 2 配線板 4 1 は第 2 端子アレイ 3 3 b に被さる。第 1 配線板 3 8 の第 1 信号線 3 9 は上電極端子 3 4 および下電極端子 3 5 に個々に接続される。第 2 配線板 4 1 の第 2 信号線 4 2 は上電極端子 3 6 および下電極端子 3 7 に個々に接続される。接合には圧着その他の接合方法が用いられればよい。

【 0 0 6 0 】

その後、図 1 1 に示されるように、基材 6 2 上で保護膜 5 3 が形成される。音響整合層 5 1 と第 1 配線板 3 8 との間および音響整合層 5 1 と第 2 配線板 4 1 との間に樹脂材 6 7 が流し込まれる。樹脂材 6 7 の供給にあたって例えばノズルが用いられてもよい。ノズルは音響レンズ 5 2 の母線に平行に第 1 配線板 3 8 の縁および第 2 配線板 4 1 の縁に沿って移動すればよい。樹脂材 6 7 は流動性を有する。樹脂材 6 7 の流し込みにあたって第 1 配線板 3 8 および第 2 配線板 4 1 上には囲い 6 8 が区画されてもよい。囲い 6 8 は例えば金型から形成されることができる。囲い 6 8 は樹脂材 6 7 の流れを堰き止めることができる。樹脂材 6 7 は熱や紫外線の照射に応じて硬化する。樹脂材 6 7 は硬化して保護膜 5 3 を形成する。樹脂材 6 6 および樹脂材 6 7 にはエポキシ樹脂が用いられてもよい。その場合には音響レンズ 5 2 はエポキシ樹脂から形成されてもよい。

【 0 0 6 1 】

(4) 変形例に係る超音波デバイス

図 1 2 は第 1 変形例に係る超音波デバイス 1 7 a を概略的に示す。超音波プローブ 1 3 の筐体 1 6 は開口 7 6 を形成する。開口 7 6 には音響レンズ 5 2 が配置される。超音波デバイス 1 7 a は支持部材 7 7 に支持される。支持部材 7 7 は筐体 1 6 の内側に結合される。結合にあたって支持部材 7 7 と筐体 1 6 との間に第 1 配線板 3 8 および第 2 配線板 4 1 は挟まれる。音響レンズ 5 2 および音響整合層 5 1 の周囲で基体 2 1 と筐体 1 6 との間に空間 7 8 が区画される。空間 7 8 は保護材 7 9 で充填される。保護材 7 9 は音響レンズ 5 2 と基体 2 1 との間に挟まれる。保護材 7 9 は音響整合層 5 1 の圧縮強さよりも大きい圧縮強さを有する。保護材 7 9 は筐体 1 6 に音響レンズ 5 2、音響整合層 5 1 および基体 2 1 を固定する。保護材 7 9 は前述の保護膜 5 3 と同様に機能することができる。その他の構造は前述の超音波デバイス 1 7 と同様である。

【 0 0 6 2 】

超音波プローブ 1 3 の製造にあたって超音波デバイス 1 7 a および支持部材 7 7 は筐体 1 6 に收容される。支持部材 7 7 が筐体 1 6 に固定されると、音響レンズ 5 2 は開口 7 6 に臨む。このとき、音響レンズ 5 2 および音響整合層 5 1 の周囲で基体 2 1 と筐体 1 6 との間に空間 7 8 が区画される。開口 7 6 の隙間から空間 7 8 に流動性を有する樹脂材は充填される。樹脂材が硬化すると、保護材 7 9 が形成される。保護材 7 9 は開口 7 6 内で音響レンズ 5 2 の移動を防止する。音響レンズ 5 2 は確実に筐体 1 6 に固定される。

【 0 0 6 3 】

図 1 3 は第 2 変形例に係る超音波デバイス 1 7 b を概略的に示す。音響レンズ 8 1 に、

10

20

30

40

50

基体 2 1 に向き合う面から基体 2 1 に向かって突き出る柱状部 8 2 が形成される。その一方で、音響整合層 8 3 には柱状部 8 2 が嵌め込まれる溝（窪み）8 4 が形成される。溝 8 4 は音響整合層 8 3 を貫通することができ、その際、柱状部 8 2 の先端は基体 2 1 に接触する。こうした構造によれば、音響レンズ 8 1 および音響整合層 8 3 の界面に沿って剪断方向に音響レンズ 8 1 および音響整合層 8 3 のずれは防止される。音響レンズ 8 1 および音響整合層 8 3 は強固に重なり合って積層体を構成する。こうした積層体は音響レンズ 8 1 の歪みの抑制をさらに強化する。その他の構造は前述の超音波デバイス 1 7 と同様である。その他、超音波デバイス 1 7 b では、前述の超音波デバイス 1 7 a と同様に、保護膜 5 3 に代わる保護材で音響レンズ 8 1、音響整合層 8 3 および基体 2 1 は超音波プローブ 1 3 の筐体 1 6 に固定されてもよい。

10

【 0 0 6 4 】

図 1 4 は第 3 変形例に係る超音波デバイス 1 7 c を概略的に示す。音響整合層 8 6 は素子アレイ 2 2 を覆う。音響整合層 8 6 は第 1 圧縮強さを有する。音響整合層 8 6 は単一層であって 1 0 0 [μm] 以下の膜厚を有し 2 [M R a y l s] 以下の音響インピーダンスを有する。ここでは、音響整合層 8 6 はエポキシ樹脂から形成される。音響整合層 8 6 上には音響レンズ 8 7 が配置される。前述と同様に、音響レンズ 8 7 は音響整合層 8 6 の第 1 圧縮強さよりも大きい第 2 圧縮強さを有する。したがって、音響レンズ 8 7 はシリコン樹脂から形成されることができる。平面視で音響レンズ 8 7 の輪郭は音響整合層 8 6 の輪郭に一致することができる。

20

【 0 0 6 5 】

基体 2 1 には保護膜（構造体）8 8 が固定される。保護膜 8 8 は例えばエポキシ樹脂といった遮水性を有する素材から形成される。ただし、保護膜 8 8 はその他の樹脂材から形成されてもよい。保護膜 8 8 は音響レンズ 8 7 および音響整合層 8 6 に接触する。ここでは、保護膜 8 8 は、音響レンズ 8 7 の母線に平行に広がり基体 2 1 に直角に交差する 2 つの仮想平面 5 4 a、5 4 b にそれぞれ沿った接触面 8 8 a で音響レンズ 8 7 および音響整合層 8 6 を挟む。このとき、音響レンズ 8 7 および音響整合層 8 6 の側面 8 7 a、8 6 a は面一に広がる。保護膜 8 8 は、音響整合層 8 6 と第 1 および第 2 配線板 3 8、4 1 との間で基体 2 1 表面の第 2 導電体 3 2 や引き出し配線 3 1 に被さる。同様に、保護膜 8 8 は、基体 2 1 上で第 1 配線板 3 8 および第 2 配線板 4 1 の端部に被さる。その他の構造は前述の超音波デバイス 1 7 と同様である。その他、超音波デバイス 1 7 c では、前述の超音波デバイス 1 7 a と同様に、保護膜 8 8 に代わる保護材で音響レンズ 8 7、音響整合層 8 6 および基体 2 1 は超音波プローブ 1 3 の筐体 1 6 に固定されてもよい。

30

【 0 0 6 6 】

音響レンズ 8 7 が生体に押し当てられると、音響レンズ 8 7 には基体 2 1 に向かって押し付け力が作用する。このとき、押し付け力の方向に音響レンズ 8 7 は音響整合層 8 6 で受け止められる。音響整合層 8 6 が音響レンズ 8 7 と同等な圧縮強さを有する場合に比べて、音響整合層 8 6 の潰れは防止される。こうして音響レンズ 8 7 に押し付け力が加わっても、音響レンズ 8 7 の歪みは防止されることができる。超音波デバイス 1 7 c では押し付け力に対して十分に音響レンズ 8 7 の歪みは抑制されることができる。音響整合層 8 6 は単一層であることから、音響整合層 8 6 が複数層で形成される場合に比べて、音響整合層 8 6 の形成工程は簡素化されることができる。しかも、音響整合層 8 6 の膜厚は高い精度で制御されることができる。ここでは、音響整合層 8 6 の音響インピーダンスは 2 [M R a y l s] 以下であることから、音響レンズ 8 7 と素子 2 3 との間で音響インピーダンスの整合は確立されることができる。例えばバルク型トランスデューサー素子に比べて音響整合層 8 6 は薄膜化される。音響整合層 8 6 の膜厚は 1 0 0 [μm] 以下に薄膜化されることができ、薄膜化に応じて音響整合層 8 6 の変形は抑制される。加えて、超音波デバイス 1 7 c は小型化される。

40

【 0 0 6 7 】

なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで

50

あろう。したがって、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれる。例えば、明細書または図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語とともに記載された用語は、明細書または図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えられることができる。また、超音波診断装置 11 や装置端末 12、超音波プローブ 13、ディスプレイパネル 15、筐体 16、基体 21、素子 23、第 1 および第 2 配線板 38、41、音響整合層 51、83、86、音響レンズ 52、81、87 等の構成および動作も本実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形が可能である。

【符号の説明】

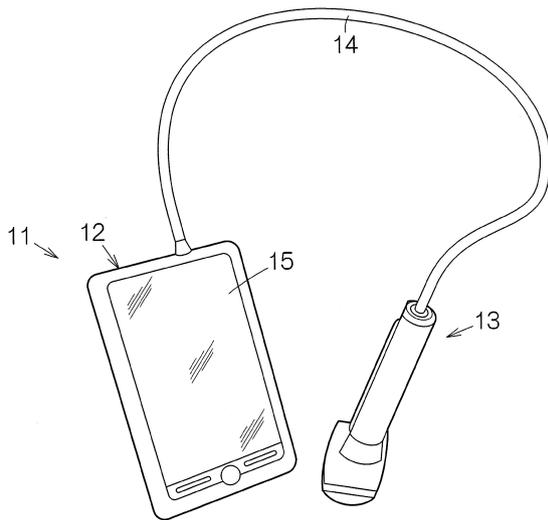
【0068】

11 電子機器および超音波画像装置としての超音波診断装置、12 処理部（装置端末）、13 プローブ（超音波プローブ）、15 表示装置（ディスプレイパネル）、16 筐体、17 超音波デバイス、17a 超音波デバイス、17b 超音波デバイス、17c 超音波デバイス、21 基板（基体）、22 素子アレイ、23 薄膜型超音波トランスデューサー素子、38 フレキシブルプリント配線板（第1フレキシブルプリント配線板）、41 フレキシブルプリント配線板（第2フレキシブルプリント配線板）、51 音響整合層、52 音響レンズ、53 構造体（保護膜）、53a 側面（接触面）、53b 側面（接触面）、53c 側面（接触面）、53d 側面（接触面）、61 基板、63 マスキング材、64 開口、67 樹脂材、79 構造体（保護材）、81 音響レンズ、82 柱状部、83 音響整合層、84 窪み（溝）、86 音響整合層、87 音響レンズ、88 構造体（保護膜）。

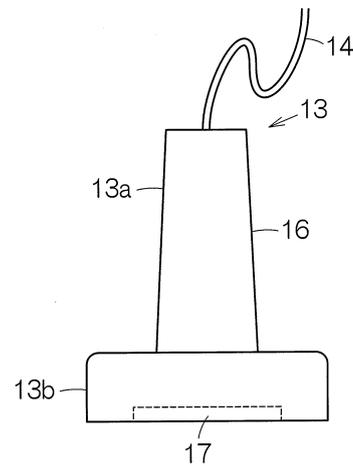
10

20

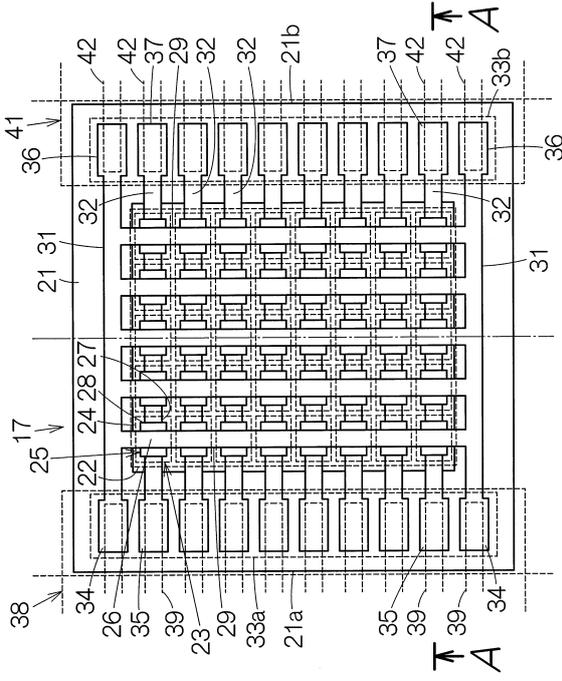
【図 1】



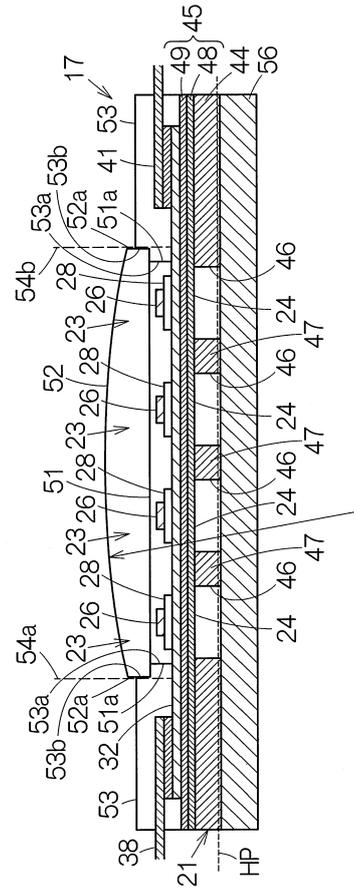
【図 2】



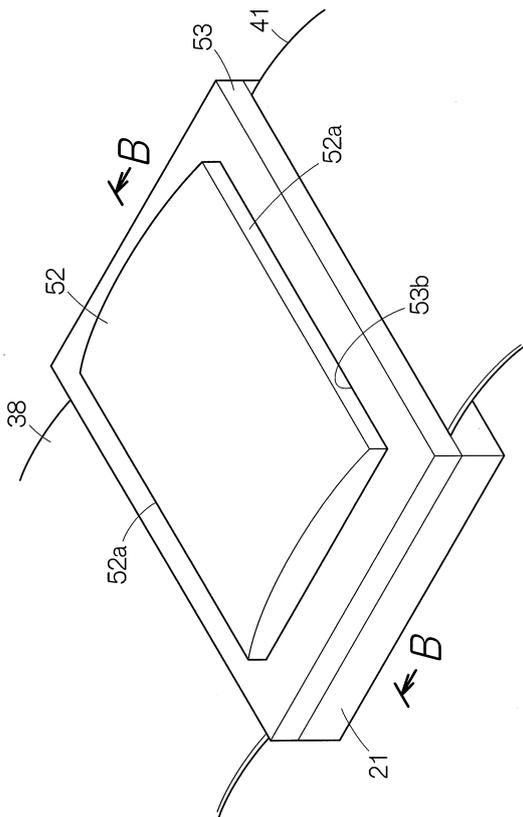
【図 3】



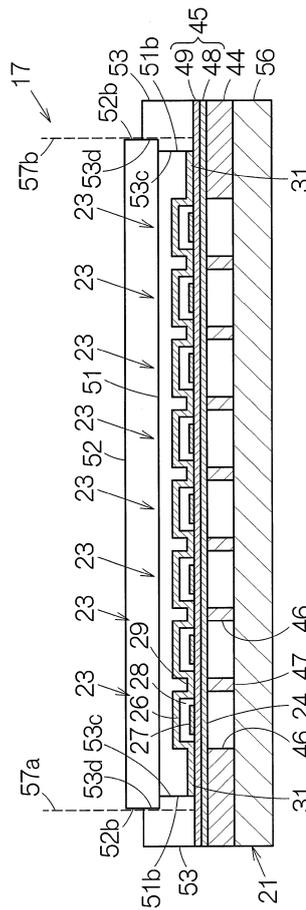
【図 4】



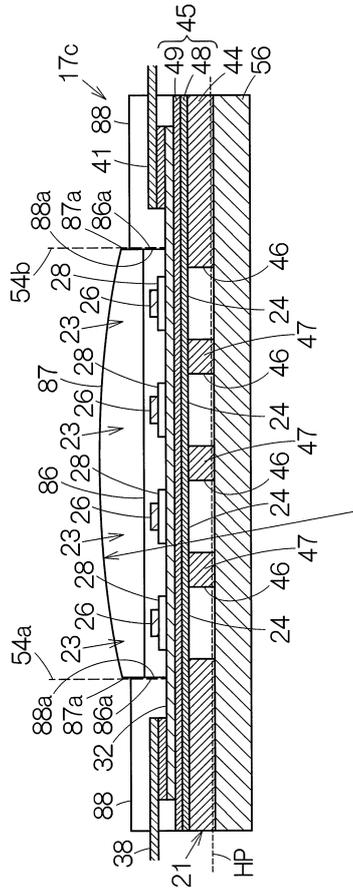
【図 5】



【図 6】



【 図 1 4 】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2011-259274(JP,A)
国際公開第2012/023619(WO,A1)
特開2013-226390(JP,A)
特開2008-270868(JP,A)
特開昭60-191600(JP,A)
特開平06-201664(JP,A)
特開平01-293851(JP,A)
米国特許出願公開第2014/0204717(US,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A61B 8/00 - 8/15
H04R 17/00 - 19/00